

⑩ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑪ Patentschrift  
⑫ DE 100 61 297 C 2

⑬ Int. Cl.<sup>7</sup>:  
**H 01 L 51/40**  
H 01 L 51/20

DE 100 61 297 C 2

⑭ Aktenzeichen: 100 61 297-0-33  
⑮ Anmeldetag: 8. 12. 2000  
⑯ Offenlegungstag: 27. 6. 2002  
⑰ Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 28. 5. 2003

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑱ Patentinhaber:  
Siemens AG, 80333 München, DE

⑲ Erfinder:  
Bernds, Adolf, 91083 Baiersdorf, DE; Clemens,  
Wolfgang, Dr., 90617 Puschendorf, DE; Haring,  
Peter, Dr., Raeren, BE; Kurz, Heinrich, Prof., 52076  
Aachen, DE; Vratzov, Borislev, 52062 Aachen, DE

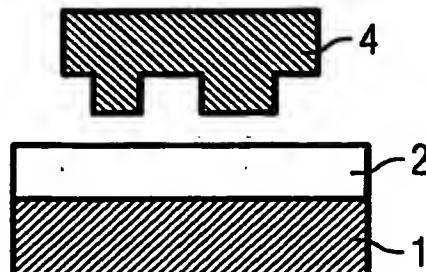
⑳ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:

DE 198 51 703 A1  
DE 100 43 204 A1  
EP 04 42 123 A1  
WO 99 10 939 A2

C.J. Drury et al.: "Low-cost all polymer integrated circuits" in "Applied Physics Letters", 73(1998)1, pp. 108-110 (von ANR bereits genannt);  
G.H. Gelinck et al.: "High-performance all-polymer integrated circuits" in "Applied Physics Letters", 77(2000)10, pp. 1487-1489;  
Xiang-Yeng Zheng et al.: "Electrochemical Patterning of the Surface of Insulators with Electrically Conductive Polymers" in "J. Electrochem. Soc.", 142(1995)12, pp. L226f.;  
M. Angelopoulos and J.M. Shaw: "In-Situ Radiation Induced Doping", in: "Mol. Cryst. Lig. Cryst.", 189(1990), pp. 221-225;

㉑ Verfahren zur Strukturierung eines OFETs

㉒ Verfahren zur Strukturierung eines organischen Feld-Effekt-Transistors (OFETs) durch Räkeln von zumindest einem Funktionspolymer in eine Negativ-Form, folgende Arbeitsschritte umfassend:  
– auf einem Substrat oder einer unteren Schicht wird eine Formschicht für eine Negativ-Form aufgebracht,  
– diese Formschicht erhält durch ein Imprintverfahren mittels einem Prägestempel Vertiefungen, die den Negativen der späteren Strukturen entsprechen und  
– In diese Vertiefungen wird dann das Funktionspolymer hinaingerakelt.



DE 100 61 297 C 2